



晶体管 TRANSISTOR TIP122D

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I _C	8A
V _{CEO}	100V
P _C	65W

用途 APPLICATIONS

高频功率变换	High frequency power transform
一般功率放大电路	Commonly power amplifier circuit

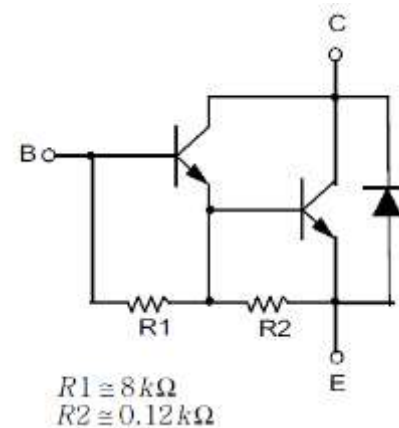
产品特性 FEATURES

硅外延	Epitaxial silicon
高电流容量	High current capability
RoHS产品	RoHS product
与 TIP127 互补	Complementary to TIP127

封装形式 Package



TO-220SD



绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (T_c=25°C)

项目 Parameter	符号 Symbol	数值 Value	单位 Unit
集电极—基极直流电压 Collector- Base Voltage (I _E =0)	V _{CBO}	100	V
集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage (I _B =0)	V _{CEO}	100	V
发射极—基极直流电压 Emitter-Base Voltage (I _C =0)	V _{EB0}	7	V
最大集电极直流电流 Collector Current (DC)	I _C	8	A
最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-92)	P _C	65	W
最高结温 Junction Temperature	T _j	150	°C
贮存温度 Storage Temperature	T _{stg}	-55~+150	°C

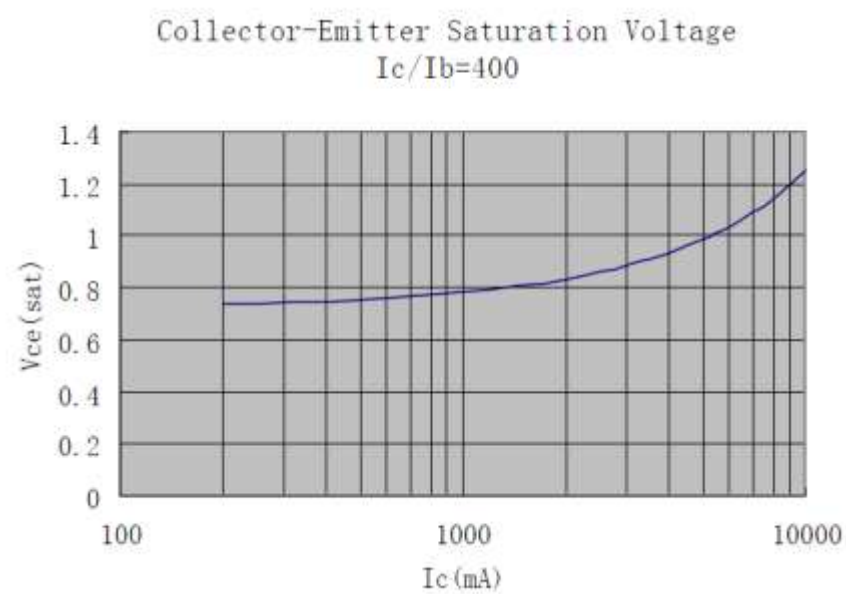
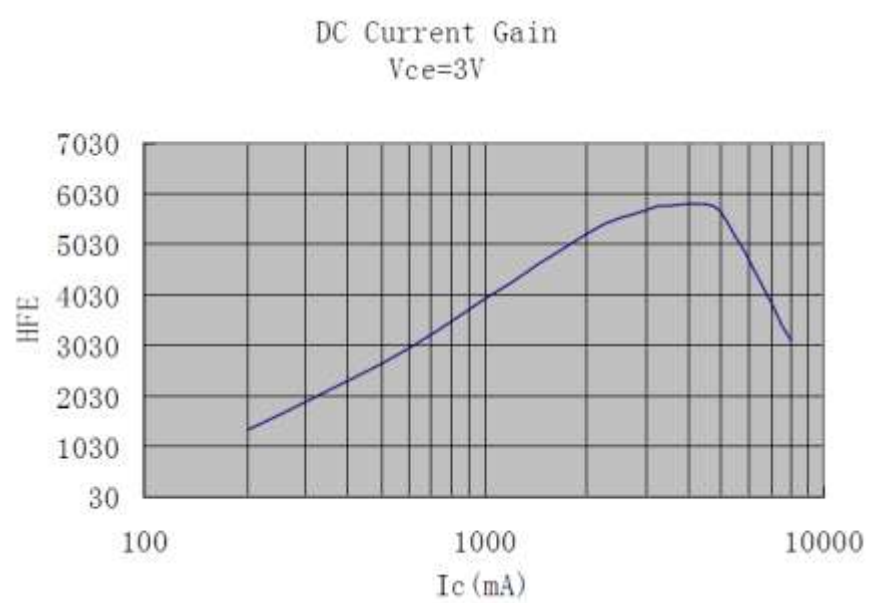
热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

项目 Parameter	符号 Symbol	最小值 (min)	最大值 (max)	单位 Unit
结到环境的热阻 Thermal Resistance Junction Ambient	R _{th(j-a)}	-	125	°C/W

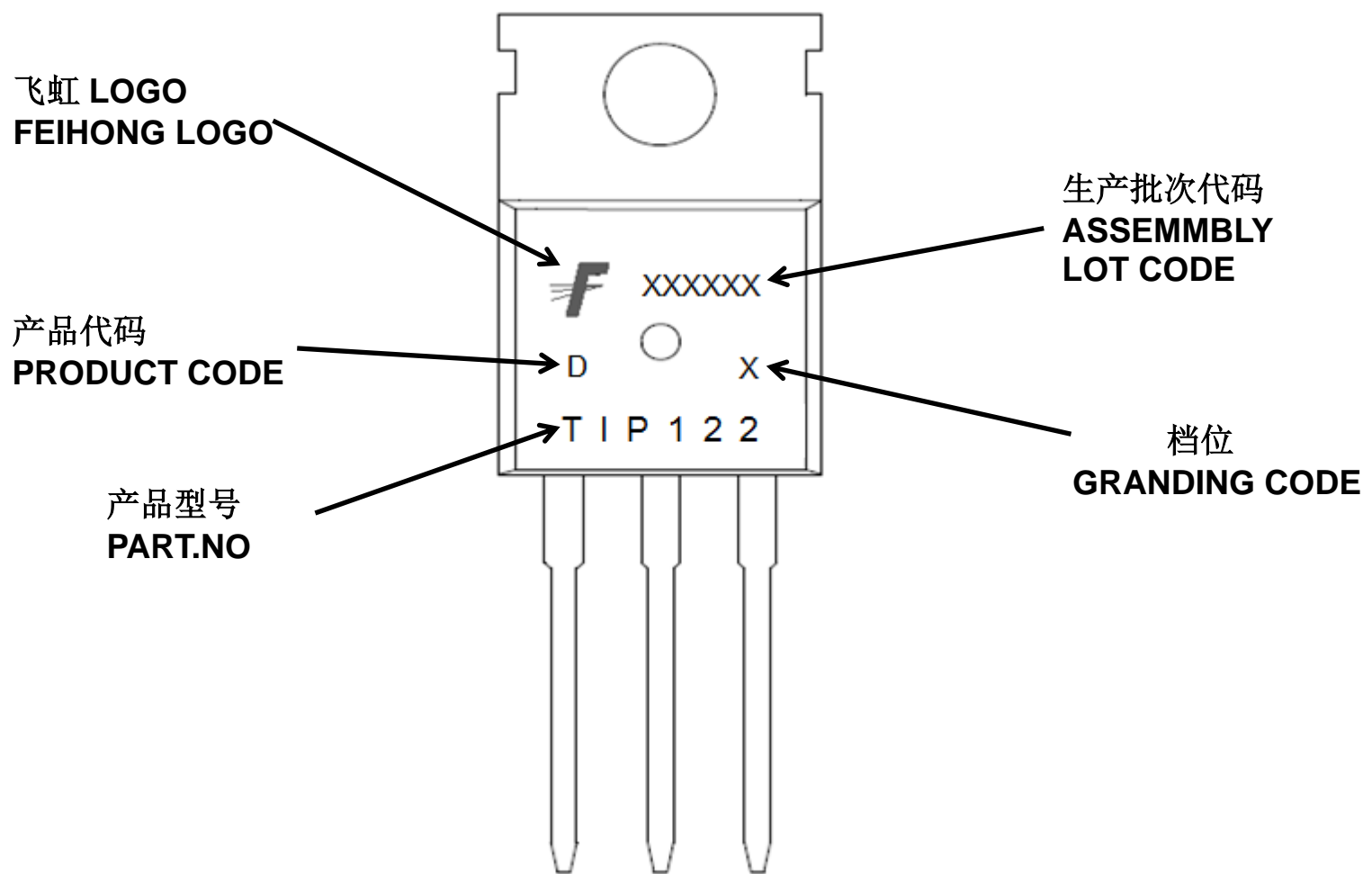
电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项目 Parameter	测试条件 Tests conditions	最小值 (min)	典型值 (typ)	最大值 (max)	单位 Unit
$V(BR)_{CBO}$	$I_C=100\mu A, I_E=0$	100	200	-	V
$V(BR)_{CEO}$	$I_C=10mA, I_B=0$	100	-	-	V
$V(BR)_{EBO}$	$I_E=1mA, I_C=0$	7	-	-	V
I_{CBO}	$V_{CB}=100V, I_E=0$			0.1	mA
I_{CEO}	$V_{CE}=100V, I_E=0$	-	-	2	mA
I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	-	-	2	mA
$H_{fe}(1)$	$V_{CE}=3V, I_C=0.5A$	1000	-	5000	
$H_{fe}(2)$	$V_{CE}=3V, I_C=3A$	1000			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=3A, I_B=12mA$	-	-	1.5	V
$V_{CE(sat)}$	$I_C=5A, I_B=20mA$	-	-	3	V

典型特性曲线 Electrical Characteristics



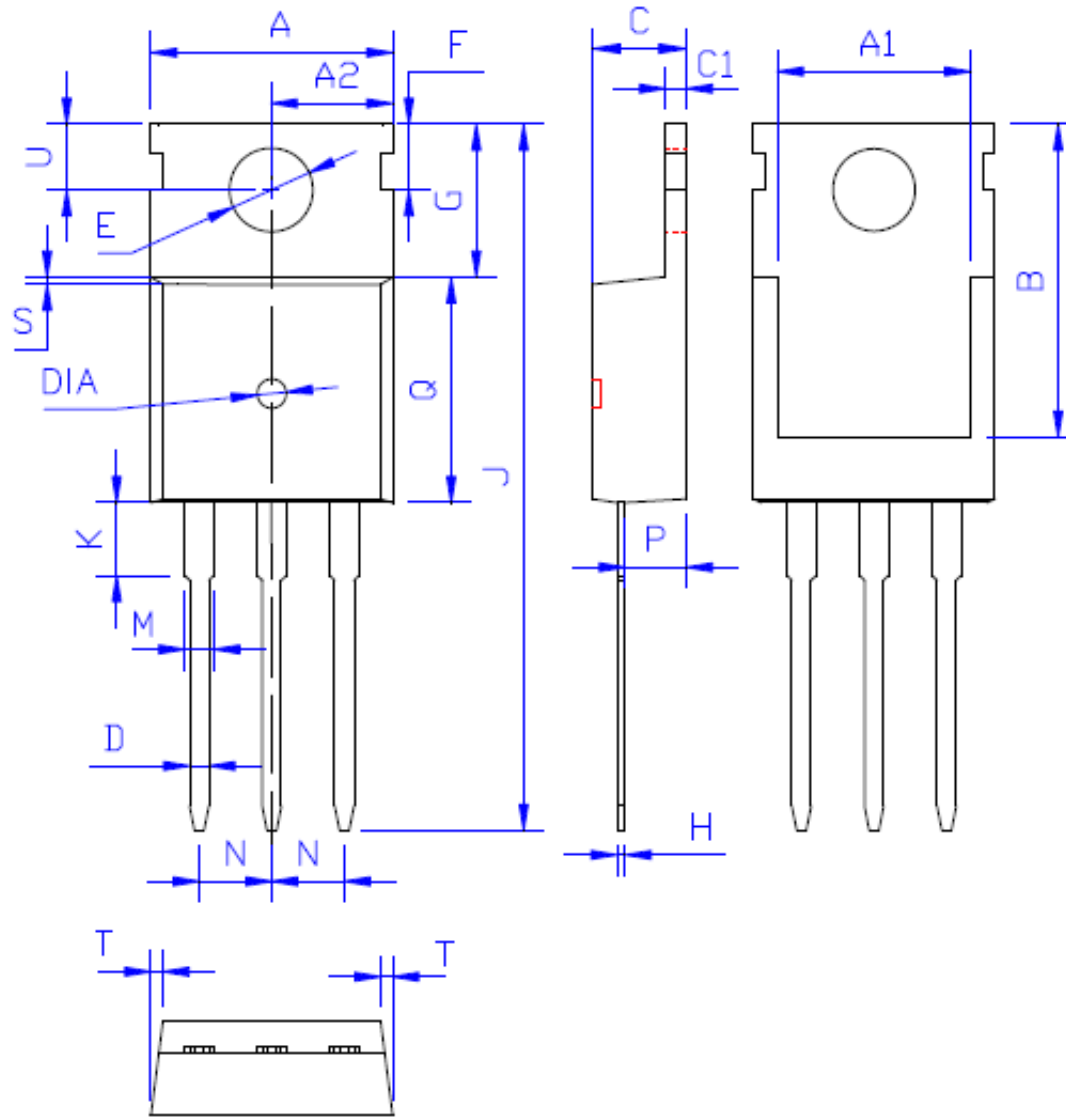
印记 Marking:



外形尺寸:

Package Dimension:

TO-220



DIM	MILLIMETERS
A	10.00±0.30
A1	8.00±0.30
A2	5.00±0.30
B	13.20±0.40
C	4.50±0.20
C1	1.30±0.20
D	0.80±0.20
E	3.60±0.20
F	3.00±0.30
G	6.60±0.40
H	0.50±0.20
J	28.88±0.50
K	3.00±0.30
M	1.30±0.30
N	Typical 2.54
P	2.40±0.40
Q	9.20±0.40
S	0.25±0.15
T	0.25±0.15
U	2.80±0.30
DIA	宽 1.50±0.10 深 0.50 MAX

(Unit: mm)